

AUIRLS3036-7P

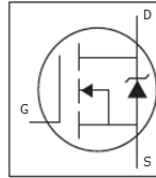
HEXFET[®] 功率MOSFET

特点

- 先进的工艺技术
- 超低导通电阻
- 动态的dv / dt额定值
- 175 °C工作温度
- 快速开关
- 重复性雪崩中允许多达TJMAX
- 无铅，符合RoHS
- 汽车合格*

描述

专为汽车应用，这HEXFET功率MOSFET采用了最新的处理技术，实现极低的导通电阻每硅片面积。另外这种设计的特点是一个175 °C的结工作温度，开关速度快，提高了重复雪崩额定值。这些功能结合起来，使这一设计一个非常有效和可靠的设备在汽车使用应用程序和各种各样的其它应用。



V_{DSS}	60V
$R_{DS(ON)}$ 典型值	1.5m Ω
马克斯	1.9m Ω
I_D (硅有限公司)	300A $\text{\textcircled{C}}$
I_D (包装有限公司)	240A



D²朴 - 7引脚封装外形

尺寸以毫米 (英寸)

